

Список публикаций оппонента Карпова С.Ю.

1. V. F. Mymrin, K. A. Bulashevich, N. I. Podolskaya, I. A. Zhmakin, S. Yu. Karpov, and Yu. N. Makarov, "Modelling of MQW LED operation", *Phys. Stat. Solidi (c)* **2** (2005) 2928-2931.
2. K. A. Bulashevich, S. Yu. Karpov, and R. A. Suris, "Analytical model for the quantum-confined Stark effect including electric field screening by non-equilibrium carriers", *Phys. Stat. Solidi (b)* **243** (2006) 1625-1629.
3. K. A. Bulashevich, V. F. Mymrin, and S. Yu. Karpov, D M Demidov, and A L Ter-Martirosyan, "Effect of Free-Carrier Absorption on Performance of 808 nm AlGaAs-Based High-Power Laser Diodes", *Semicond. Sci. Technol.* **22** (2007) 502-510.
4. S. Yu. Karpov, "Effect of localized states on internal quantum efficiency of III-nitride LEDs", *Phys. Status Soildi RRL*, **4** (2010) 320-322.
5. D. A. Zakheim, A. S. Pavluchenko, D. A. Bauman, K. A. Bulashevich, O. V. Khokhlev, and S. Yu. Karpov, "Efficiency droop suppression in InGaN-based blue LEDs: Experiment and numerical modelling", *Phys. Stat. Solidi (a)* **209** (2012) 456-460.
6. Д. М. Демидов, А. Л. Тер-Мартirosян, К. А. Булашевич, О. В. Хохлев, С. Ю. Карпов, "Мощные лазерные диоды с длиной волны излучения 808 нм. III. Пути повышения мощности излучения", *Научное приборостроение* **23** (2013) 19-25.
7. А. Л. Тер-Мартirosян, Д. М. Демидов, М. А. Свердлов, А. В. Кулик, С. Ю. Карпов, "Анализ и оптимизация конструкции теплоотводов для мощных лазерных диодов. I. Теплоотвод традиционной конструкции", *Научное приборостроение* **23** (2013) 40-44.
8. А. Л. Тер-Мартirosян, Д. М. Демидов, М. А. Свердлов, А. В. Кулик, С. Ю. Карпов, "Анализ и оптимизация конструкции теплоотводов для мощных лазерных диодов. II. Пути улучшения отвода тепла", *Научное приборостроение* **23** (2013) 45-49.
9. S. Yu. Karpov, "Strategies for creating efficient, beautiful whites", *Compound Semiconductors*, **21** (2015) 44-47.
10. F. Nippert, S. Karpov, I. Pietzonka, B. Galler, A. Wilm, T. Kure, C. Nenstiel, G. Callsen, M. Straßburg, H.-J. Lugauer, and A. Hoffmann, "Determination of recombination coefficients in InGaN quantum-well light-emitting diodes by small-signal time-resolved photoluminescence", *Jpn. J. Appl. Phys.* **55**, 05FJ01 (2016).
11. F. Nippert, S. Yu. Karpov, G. Callsen, B. Galler, T. Kure, C. Nenstiel, M. R. Wagner, M. Straßburg, H.-J. Lugauer, and A. Hoffmann, "Temperature-dependent recombination coefficients in InGaN light-emitting diodes: hole localization, Auger processes and the green gap", *Appl. Phys. Lett.* **109**, 161103 (2016).